B-doped p-BaSi₂/n-Si ヘテロ接合太陽電池へのポストアニール効果

Effect of post annealing on B-doped p-BaSi₂/n-Si heterojunction solar cells

筑波大¹, ⁰成田 隼翼¹, 山下 雄大¹, 青貫 翔¹, 都甲 薫¹, 末益 崇¹

Univ. Tsukuba¹, ^oShunsuke Narita¹, Yudai Yamashita¹, Sho Aonuki¹, Kaoru Toko¹, Takashi Suemasu¹

E-mail: s2120288@s.tsukuba.ac.jp

【背景・目的】 薄膜太陽電池の新材料として BaSi₂に注目した。BaSi₂は地殻中に豊富に存在する元素で構成される半導体であり、禁制帯幅(1.3 eV)が太陽電池に適している¹⁾。また、BaSi₂は大きな光吸収係数(3×10⁴ cm⁻¹@1.5 eV)と優れた少数キャリア拡散長(10 µm)を有しており、低コストかつ高効率な薄膜太陽電池材料として期待される¹⁾。太陽電池応用に向けて、p-BaSi₂光吸収層の高品質化が非常に重要である。従来の BaSi₂太陽電池の光吸収層には undoped BaSi₂に比べ安定して p型伝導を示し、より高い分光感度を示す B-doped p-BaSi₂を用いる²⁾。近年、B-doped p-BaSi₂膜に高温のポストアニールを施すと、分光感度が向上した³⁾。本研究では、ポストアニール処理を B-doped p-BaSi₂/n-Si ヘテロ接合太陽電池に応用し、太陽電池特性の向上を目的とした。

【実験】 MBE 法により Si 基板上に B-doped BaSi₂ 膜をエピタキシャル成長させた。まず、Ba のみを供給する RDE 法により、加熱した Si(111)基板 ($\rho = 1 - 4 \ \Omega cm$)上に BaSi₂ テンプレート層を作製した。その後 Ba、Si、B を同時供給する MBE 法により, B-doped BaSi₂ 膜を堆積した。B-doped BaSi₂ 膜の膜厚を変換効率が最大とな る 20 nm に設定した⁴⁾。さらに表面パッシベーションとして a-Si のキャッピング層を 3 nm 堆積した。その後、RTA

装置を用いて、Ar 雰囲気中でポストアニールを行った。アニール温度を1000 $^{\circ}$ Cに昇温し、アニール時間 t_a を15 s – 5 min に設定し、高温ポストアニールを行った。本研究では、これらの試料に対して、太陽電池測 定とAFMを用いて評価した。

【結果・考察】Fig.1に太陽電池測定の結果を示す。 t_a = 30 s - 5 min の試料はアニール後の開放電圧が 大きくなり、変換効率が最大 5.0%に達した。これは、 非熱処理時に比べ約 2.5 倍の値であり、ポストアニー ルによってキャリア分離を促進したといえる。一方で、 t_a = 15 s の試料は、変換効率が減少した。Fig. 2 に AFM 像を示す。 $t_a = 30 \text{ s}$ の試料は表面様態に大き な変化はなかった。一方、 $t_a = 5 \min$ の試料表面に は BaSi2 膜の剥離箇所が見られた。これより、ポストア ニールによって BaSi2 膜の膜質が向上し太陽電池特 性が向上したが、30 s以上の加熱では、BaSi2 膜の剥 離により表面様態が劣化し、太陽電池特性が低下し たと考えられる。しかし、ta=5minの試料でも非熱処 理時に比べて太陽電池特性が向上したことから、表 面様態以上にポストアニールが大きな効果を有して いるといえる。



Fig.1 *J-V* characteristics of B-doped p-BaSi₂/n-Si heterojunction solar cells annealed at various t_a in the range from 15 s to 5 min measured under AM1.5 illumination at RT.



Fig.2 AFM images of as-grown B-doped p-BaSi₂/n-Si heterojunction solar cells and those annealed at $t_a = 15$ s and 5 min.

【参考文献】

- 1) T. Suemasu and N. Usami, J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 023001 (2017).
- 2) K. Kodama et al., Appl. Phys. Express 12, 041005 (2019).
- 3) S. Narita et al., Journal of Crystal Growth 578, 126429 (2022).
- 4) S. Yachi et al., Jpn. J. Appl Phys. 56, 05DB03 (2017).